

電子デバイス



部門紹介

パワー半導体を主力事業と位置づけ、半導体製造技術を応用したディスク媒体、感光体、太陽電池の各事業を展開しています。

特に、代表的なパワー半導体であるIGBTは、世界トップクラスのシェアを有し、電力変換を担うキーデバイスとして、インバータや工作機械、ロボットなどの産業分野、ハイブリッド車などの自動車電装分野、さらには風力・太陽光発電などの新エネルギー分野といった、幅広い分野で省エネ化や高効率化に貢献しています。

さらに次世代パワーデバイスであるSiCの開発により、パワーエレクトロニクス製品のさらなる省エネ化・小型化に貢献します。

2011年度の主な取り組み

半導体分野は、産業分野における省エネニーズへの対応として、業界最高レベルの低損失化により、パワーエレクトロニクス機器の小型・省エネ化を実現する「第6世代IGBT Vシリーズ」を開発、市場投入しました。また、地震・電力供給のリスク分散に向け、従来ディスク媒体の生産拠点であっ

た山梨工場を半導体の前工程工場として整備を進めました。

ディスク媒体分野は、マレーシアへの営業・開発・生産拠点の集約による事業構造改革を推進し、単年度黒字化を果たしました。

2012年度の方針・戦略

● パワー半導体の事業体質の強化

- 徹底した原価低減
- 自動車向け半導体事業の拡大
- 産業用IGBTの海外生産拡大(中国 深圳工場)

パワー半導体市場は、世界的な省エネ需要の高まりを受け、IGBT(産業用・自動車用)は、今後3年間で年平均11%、自動車電装は同10%の市場伸長が見込まれています。

このようななか、当社はIGBTに注力し、電気自動車/ハイブリッド自動車向け、および風力・太陽光発電システム向けの開発を強化し、日本、中国、欧州市場を中心に売上高の拡大を図ります。また、小容量の民生用IGBTの市場投入や大容量品のラインアップ拡充を図るとともに、SiCの量産化に取り組みます。

2012年7月の(株)ルネサス北日本セミコンダクタ津軽工場の買収により、事業継承する自動車電装分野向け製品を取り込むことで、事業ポートフォリオの拡大を図ります。中国におけるIGBTの売上拡大に向け、中国・深圳の後工程工場の生産開始により、現地の要求仕様に対応する体制を構築します。また、海外部材調達の拡大を含め、徹底した原価低減活動を通じて、損益体質の強化を図ります。

	2011年度	2012年度予想	増減
売上高	1,122	1,276	+167
(うち海外)	717	779	+62
営業利益	-2	40	+42

感光体事業は、新興国を中心に需要が拡大するカラープリンタ、複合機向けに製品ラインアップを拡充し、事業の拡大を図ります。

ディスク媒体分野では、マレーシアで開発・生産・販売の一貫体制を活かし、高品質・低コストによる収益を重視した事業展開を進めます。

パワー半導体の世界市場予測

